◎ 公開特許公報(A) 平4-195831

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月15日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 B 7215-5D

8305-2H B 41 M 5/26

X

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

60発明の名称 光学情報記録再生消去部材

②特 顧 平2-322745

22出 願 平2(1990)11月28日

@発明者森谷宏一神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作

所家電研究所内

@発明者 徳宿 伸弘 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作

所家電研究所内

⑫尧 明 者 太 田 康 博 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所家電研究所内

而出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

光学情報記録再生消去部材

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. レーザ光の照射により、そのエネルギーを吸収し、溶融し、急冷し、アモルファスの化する性質とアモルファスの状態を昇温録膜を記録により情報を記録である。 ではより結晶化する性質を有する記録膜に記録膜において、前記レーザ光の強度変調に記録線に記録機構に記録接続によりにおいて、前記記録機構膜を有する光学では、さらに上記有機構成で、さらに上記有機構成で、下面の少なくとも1方に屈折率が2.0以上の誘電体層を設けることを特徴とする光学情報記録再生消去部材。
 - 額求項1記載の有機薄膜の材料として、エチレンフッ化物、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミドのうち少なくとも1種類を用いることを特徴とする光学情報記録再生消去部材。
- 3. 請求項1記載の有機薄膜の膜厚を 200人以下

にすることを特徴とする光学情報記録再生消去 部材。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はレーザビーム等により、情報を高密度、 大容量で記録再生、及び消去できる光学記録再生 消去部材に関するものである。

〔従来の技術〕

光ディスクメモリに関しては、TeとTeOを主成分とするTeOx(0 < x < 2.0) 薄膜を用いた追記形のディスクがある。さらに、レーザ光により薄膜を加熱し、溶融し、急冷することにより、非晶質化し情報を記録しまたこれを加熱し、徐冷することにより結晶化し、消去できる材料としては、S.R.Oveshinsky 氏等のカルコゲン材料 GeisTeal Sbz Sz 等が知られている。 また、Asz Sz や Asz Se, あるいは Sbz Se 等カルコゲン元素と 周期律表第5族 あるいは Ge等の第6族の組合せからなる薄膜等が広く知られている。ディスク構成としては、第3図に示すように、記録部材の熱

的安定性および記録と消去のサイクル安定性を目 的として記録膜4に隣接して耐熱性に優れた誘電 体層2をその両側に形成し、反射層5を散ける。 誘電体層 2 の厚さは、記録膜 4 の光学定数の変化 による反射事変化比が最大になるように決められ る。これらに薄膜にレーザ光を照射し、情報を記 録し、その情報を消去する方法としては、予め記 録膜を結晶化させておき、これに 1 μm 程度に絞 ったレーザ光を情報に対応させて強度変調を施し、 例えば、円盤状の記録ディスクを回転せしめて照 射し、このレーザ光照射部位は、薄膜の融点以上 に昇温し、かつ急冷し、非晶質化したマークとし て情報の記録が行なえる。この情報を消去する際 においては、ディスクの回転トラック方向に長い スポットを照射することにより、薄膜を加熱昇温 させ、長いスポット光による徐冷効果によって再 び結晶化させる方法が知られている。

(発明が解決しようとする課題)

情報の記録は、結晶領域に情報に対応したアモ ルファスマークを形成することにより行う。情報

(実施例)

本発明による実施例を図面を用いて詳細に説明する。

〔実施例1〕

基板としては、予めレーザ光案内用溝あるいは ピット列を形成したポリカーボネート樹脂基板あ の消去には、アモルファスマークを長いスポット 光による徐冷効果によって再び結晶化させる。こ の際、第4図に示すように、結晶領域に形成され たアモルファスマークにレーザ光をあるパワーで 1回照射した場合、結晶化する領域がアモルファ スマークの幅よりも狭くなり、情報が完全に消去 できないという問題があった。

本発明の目的は、消去特性の良好な膜構成を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、レーザ光等の照射により熱的に薄膜の状態を変化させて情報を記録及び消去する部材において、記録薄膜に隣接して高融点の有機材料からなる保温層を形成するものである。

(作用)

記録膜に隣接して有機材料からなる保温層を形成することにより、記録膜は効率良く加熱される。これは無機材料に比べ熱伝導率の小さい有機材料を保温層として用いることにより、記録膜からの熱放散が少なくなり記録膜の時間に対する放熱特

るいはガラス基板を用いる。このような基板上に 各層をスパッタ法により形成する。この際の構成 を第1図に示す。基板1上にまず誘電体層2とし て Z n S - S i O 2を800人、保温層3としてテフロ ンを200人、 記録膜 In, S b T e 2を300人、保温層 3としてテフロンを200人、 誘電体層2として Z n S - S i O 2を1000人、反射層5としてNi-Cr (60:40原子%)を1000人順次形成する。この上 に更に紫外線硬化樹脂、ホットメルト系接着剤を 形成し、これを2枚貼りあわせてディスクとする。

このディスクを1800rpmで 5 M H z の信号を記録しこれにレーザ光をそのパワーを変えて1 回照射し、消去比の測定を行なった。この結果を第 5 図に示す。 消去比はレーザパワー 7 m W で最高の40dBとなった。 又書き換え特性の測定結果を第 6 図に示す。書き換え回数に大きな違いは無いが、10000 回までC / N は全く低下しない。これは 基板変形による基板界面の層間剥離によるノイズが発生しないためである。

尚、保温層の膜厚が厚くなると、保温層を構成

する材料が記録膜への情報の記録時の加熱過程で体積変化を起し、書き換えによるノイズの上昇が起る。このため保温層の膜厚は 200 A 以下が効果的である。

[実施例2]

本実施例においては、記録膜の基板側界面に保温層を形成した場合について説明する。第2図に本実施例のディスク構成をしめす。基板1上に誘電体層22ns-siOzを800人、保温層3ポリイミドを200人、記録膜In,SbTezを300人、誘電体層22ns-siOzを1000人、反射層5Ni-Cr(60:40原子%)を1000人順次形成する。この上に更に紫外線硬化樹脂、ホットメルト系接着剤を形成(図示せず)し、これを2枚貼りあわせてディスクとする。

このディスクを1800rpmで 5 M H z の信号を記録 しこれにレーザ光をそのパワーを変えて1回照射 し、消去比の測定を行なった。この結果を第7図 に示す。 消去比はレーザパワー 8 mW で最高の 40dBとなった。 又書き換え特性の測定結果を第 8 図に示す。 書き換え回数に大きな違いは無いが、 10000回までC / N は全く低下しない。 これは基 板変形による基板界面の層間剥離によるノイズが 発生しないためである。

本実施例においてポリイミドを用いたが、ポリアミドイミドを同様に用いてもその効果は変わらない。

〔発明の効果〕

- (1) 保温層を形成することにより、レーザによる結晶化幅が広がり情報の完全な消去が行える。

4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例1のディスク構成図、第2図は実施例2のディスク構成図、第3図は従来のディスク構成図、第5図は実施例1の構成のディスクにおける消去特性図、第6図は実施例1の構成のディスクにおける書き換え特性図、第7図は実施例2の構成のディスクにおける消去特性図、第8図は実施例2の構成のディ

スクにおける書き換え特性図である。

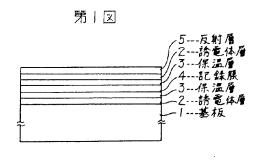
1 … … 基板

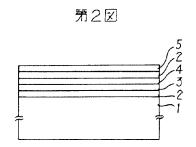
2 … … 誘電体層

3 … … 保温層

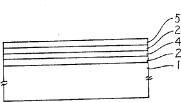
4 … … 記録膜

5 … … 反射層





第3回



第5区 DC 光 1回 照射 0 2 4 6 8 10 12 14 16 レーザパフ (mW)

第4図

